

「革新的次世代デバイスを目指す材料とプロセス」第3回領域会議および
合同発表会プログラム（暫定版）

於：浅草セントラルホテル

10月30日（木）

次世代デバイス領域会議

- 13:10～13:20 開会にあたって 佐藤 勝昭 研究総括
13:20～14:50 二期生発表（発表10分、質疑15分）
研究者1
研究者2
研究者3
14:50～15:10 休憩、事務局でのチェックイン
15:10～16:00 アドバイザー基調講演
谷垣 勝己 アドバイザー
16:00～16:10 休憩または調整時間
16:10～17:40 二期生発表
研究者4
研究者5
研究者6
17:40～18:00 総合討論
18:30～20:30 継続討論会（夕食）

今回はその後のフリーディスカッションの設定はしておりません。

10月31日（金）

- 7:00～ 8:00 朝食 → 領域会議までにチェックアウト

次世代デバイス領域会議（2日目）

- 8:20～ 9:20 二期生発表
研究者7
研究者8
9:20～ 9:30 休憩
9:30～10:30 二期生発表
研究者9
研究者10
10:30～10:50 アドバイザー総評
10:50～11:00 休憩

合同シンポジウム

- 11:00～11:10 総括の挨拶と領域紹介（5分+5分）
11:10～12:10 次世代デバイス発表（10分+質疑15分+他5分）
白石 誠司 研究者「分子を介したスピン流の制御」

齊藤 英治 研究者「誘電体スピントロニクス材料開拓とスピン光機能」

12:10～13:10 昼の休憩（弁当を注文）

13:10～15:10 ナノ製造発表（10分+質疑15分+他5分）

前田優研究者（CNT 関連）

吾郷浩樹研究者（CNT 関連）

内藤泰久研究者（ナノギャップ）

藤田淳一研究者（超尖鋭プローブ）

15:10～15:20 休憩およびポスター会場へ移動

15:20～16:00 一期生ポスター発表1

16:00～16:40 一期生ポスター発表2

16:40～17:10 一期生ポスター発表3（または総合ディスカッション）

17:10～17:20 総括総評（5分×2名）

17:20～17:30 集合写真撮影

18:00～20:00 夕食および継続討論会（ナノ製造のみ）

11月 1日（土）

ナノ製造領域会議